

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Шевяков Василий Иванович
2	Дата рождения (полная)	19.04.1952
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре интегральной электроники и схемотехники
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	124498, Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1 https://www.miet.ru/ , email: netadm@mieee.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Автономное учреждение
	Наименование подразделения	Кафедра интегральной электроники и микросистем
	Должность	Профессор кафедры
7	Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):	
	<p>1. Горностай-Польский, В. С. Исследование влияния плазменной обработки на свойства сформированных химическим осаждением из газовой фазы тонких пленок нитрида титана / В. С. Горностай-Польский, В. И. Шевяков // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2022. – Т. 27. – № 6. – С. 715-722. – DOI 10.24151/1561-5405-2022-27-6-715-722.</p> <p>2. Carbon tip aperture cantilevers: Fabrication & features in near-field magneto-optical imaging / Y. E. Vysokikh, S. Y. Krasnoborodko, M. F. Bulatov [et al.] // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2021. – Vol. 529. – P. 167837. – DOI 10.1016/j.jmmm.2021.167837.</p> <p>3. Металлизация высокотемпературных кремниевых ИС на основе сплава вольфрама с титаном / А. Н. Белов, А. А. Голишников, Д. А. Костюков, В. И. Шевяков // Известия высших учебных заведений. Электроника. – 2019. – Т. 24. – № 1. – С. 22-29. – DOI 10.24151/1561-5405-2019-24-1-22-29.</p>	

	<p>4. Study of the Formation Process of Memristor Structures Based on Copper Sulfide / A. N. Belov, A. A. Golishnikov, A. M. Mastinin [et al.] // Semiconductors. – 2019. – Vol. 53. – No 15. – P. 2024-2028. – DOI 10.1134/S1063782619150041. – EDN LJNNCA.</p> <p>5. Tertiary pyroelectric effect in TGS group crystals / A. V. Solnyshkin, V. I. Shevyakov, A. A. Golishnikov [et al.] // Ferroelectrics. – 2019. – Vol. 550. – No 1. – P. 36-41. – DOI 10.1080/00150193.2019.1652495. – EDN LYPEAQ.</p> <p>6. Особенности создания мемристорных структур на основе сульфида меди / А. Н. Белов, А. М. Мاستинин, А. А. Перевалов, В. И. Шевяков // Наноиндустрия. – 2019. – № S(89). – С. 241-243. – DOI 10.22184/NanoRus.2019.12.89.241.243. – EDN ZHEXKX.</p> <p>7. Голишников, А. А. Исследование процесса глубокого плазменного травления кремния для создания 3D-TSV-структур / А. А. Голишников, М. Г. Путря, В. И. Шевяков // Наноиндустрия. – 2019. – № S(89). – С. 244-245. – DOI 10.22184/NanoRus.2019.12.89.244.245. – EDN HDVEXV.</p> <p>8. Dielectric properties of composite materials based on P(VDF-TrFE) copolymer and deuterated triglycine sulfate crystal / A. V. Solnyshkin, A. A. Golishnikov, A. N. Belov [et al.] // Functional Materials Letters. – 2019. – Vol. 12. – No 4. – P. 1950048. – DOI 10.1142/S1793604719500486. – EDN WJSPGY.</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты